

BSY 34

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor
im TO 39-Gehäuse für den Einsatz
in der Datenverarbeitung und als Kerntreiber

Bauform 1 TO39

Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 220 \text{ K/W}$
 $R_{thjc} \leq 60 \text{ K/W}$

Grenzwerte

U_{CBO}	= 60 V	I_B	= 200 mA
U_{CES}	= 60 V	ϑ_j	= 200 °C
U_{CEO}	= 40 V	ϑ_{stg}	= -65 ... +200 °C
U_{EBO}	= 5 V	P_{tot}	= 2,6 W (bei $\vartheta_a = 45 \text{ °C}$)
I_C	= 600 mA		

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25 \text{ °C}$)

I_{CBO}	(bei $U_{CBO} = 50 \text{ V}$)		70 nA
$U_{(BR)CEO}$	(bei $I_{CEO} = 10 \text{ mA}$)		40 V
$U_{(BR)CES}$	(bei $I_{CES} = 10 \text{ } \mu\text{A}$)		60 V
U_{CEsat}	(bei $I_C = 500 \text{ mA}$, $I_B = 50 \text{ mA}$)		1,0 V
U_{BEsat}	(bei $I_C = 500 \text{ mA}$, $I_B = 50 \text{ mA}$)		1,5 V
h_{21E}	(bei $U_{CE} = 1 \text{ V}$, $I_C = 100 \text{ mA}$)		25
h_{21E}	(bei $U_{DE} = 1 \text{ V}$, $I_C = 500 \text{ mA}$)		10

Dynamische Kennwerte ($\vartheta_a = 25 \text{ °C}$)

f_T	(bei $U_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 30 \text{ mA}$, $f = 100 \text{ MHz}$)	\leq	250 MHz
t_{on}	(bei $I_C = 500 \text{ mA}$, $I_{B1} = 50 \text{ mA}$,	\leq	50 ns
t_{off}	$I_{B2} = 25 \text{ mA}$, $R_L = 80 \text{ Ohm}$)	\leq	95 ns